

Efficient Power Conversion (EPC)、USB-C バッテリー充電器や超薄型 POL (負荷点) コンバータの高電力密度ソリューションに最適な耐圧 40 V の eGaN FET を発売

EPCは、40 V、3 mΩのeGaN® FETである[EPC2055](#)を発売し、高性能がかつ要求され、スペースに制約のある用途向けに、現在利用可能なデバイスよりも小型、高効率で、信頼性の高いデバイスを設計者に提供します。

エンハンスメント・モード窒化ガリウム・オン・シリコン (eGaN) のパワーFETとICの世界的リーダーであるエフィシエント・パワー・コンバージョン社 (EPC : Efficient Power Conversion Corporation、本社：カリフォルニア州エルセグンド) は12月23日、eGaN FET の「[EPC2055](#)」 (3 mΩ、40 V) の発売によって、既製の低耐圧の窒化ガリウム・トランジスタの性能向上が進展すると発表しました。

このデバイスは、USB-Cバッテリー充電器や超薄型POL (負荷点) コンバータなど、スペースに制約のある形状での高性能が要求されるアプリケーションに最適です。EPC2055の高速スイッチング速度と超高効率が貢献する他の低耐圧用途には、LED (発光ダイオード) 照明、12 V~24 V入力のモーター駆動、ロボット、ドローン、自動運転車向けLidar (光による検出と距離の測定) システムなどがあります。

「EPC2055は、GaN FET技術の急速な進歩の非常に良い例です。この40 Vのデバイスは、前世代の40 VのGaN FETと比べて、小型で寄生容量が少ないこと、および、低コストの両方を提供します。したがって、設計者に性能向上とコスト削減の両方を提供します」と共同創業者でCEO (最高経営責任者) のAlex Lidow (アレックス・リドウ) は述べています。

開発基板の [EPC90132](#) は、最大デバイス電圧 40 V、最大出力電流 25 A、ゲート駆動回路と、eGaN FET ([EPC2055](#)) のハーフブリッジを搭載しています。この面積 2 インチ×2 インチ (50.8 mm×50.8 mm) の基板は、最適なスイッチング特性を実現するように設計されており、EPC2055 を簡単に評価するためのすべての重要な部品を搭載しています。

EPC は、エンハンスメント・モード窒化ガリウムに基づいたパワー・マネージメント (電源管理) ・デバイスのリーダーです。EPC は、最高のシリコン・パワーMOSFET よりも何倍も優れたデバイス特性を備えたエンハンスメント・モード窒化ガリウム・オン・シリコン (eGaN) FET を初めて製品化しました。[DC-DC コンバータ](#)、[ワイヤレス・パワー伝送](#)、[包絡線追跡](#)、[自動車](#)、[パワー・インバータ](#)、[リモート・センシング技術 \(LIDAR\)](#)、[D 級オーディオ・アンプ](#) などの用途で、パワーMOSFET を置き換えられます。日本語ウェブサイトは www.epc-co.com/epc/jp/ です。eGaN は、Efficient Power Conversion Corporation, Inc.の登録商標です

報道関係の問い合わせ先:

Efficient Power Conversion Corporation: Winnie Wong 電子メール : winnie.wong@epc-co.com